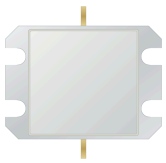
8500–9600 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 51 dBm (典型值)

LCT-8500-9600-PS51T · 8500–9600 MHz · GaN 内匹配功率晶体管.

RF 电气表参数: PSAT 51 dBm (典型值); 功率增益 9 dB (典型值); PAE 38 % (典型值).
RF 测试条件: Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm.



CMW025B

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

RF 特性

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	8500	-	9600	MHz
饱和输出功率	-	50	51	-	dBm
功率增益	-	8	9	-	dB
功率附加效率	-	-	38	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	±0.8	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极工作电压	-	-	-	-	28	V
栅极工作电压	-	-	-	-	-3	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	45	dBm
最高沟道温度	-	-	-	200	°C

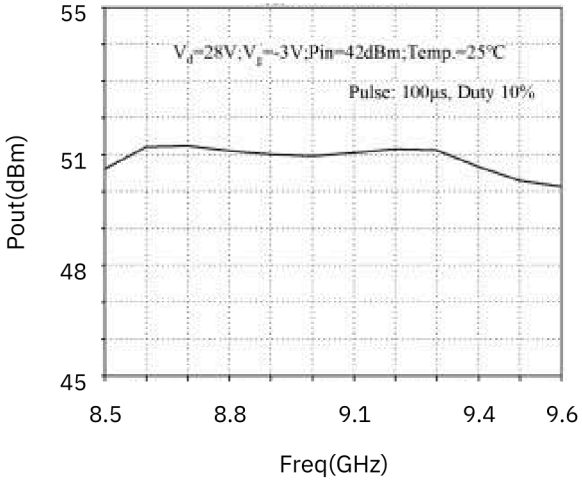
当前出版记录 · 1.5 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.4.

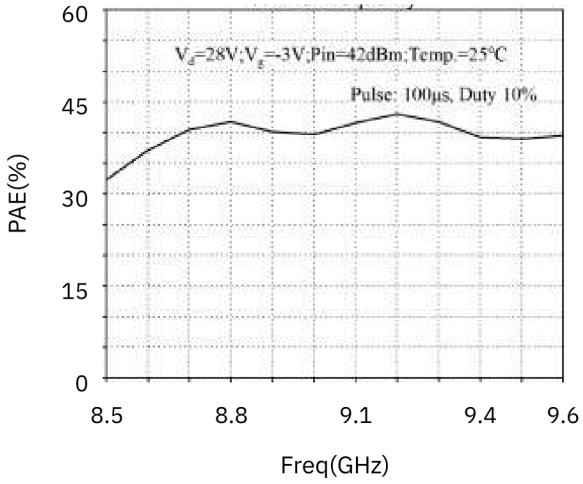
集成说明

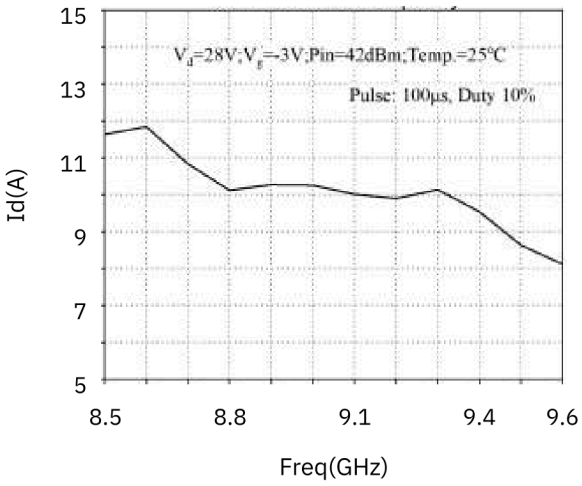
CMW025B 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF G: RF输入 D: RF输出 S: 源极／接地

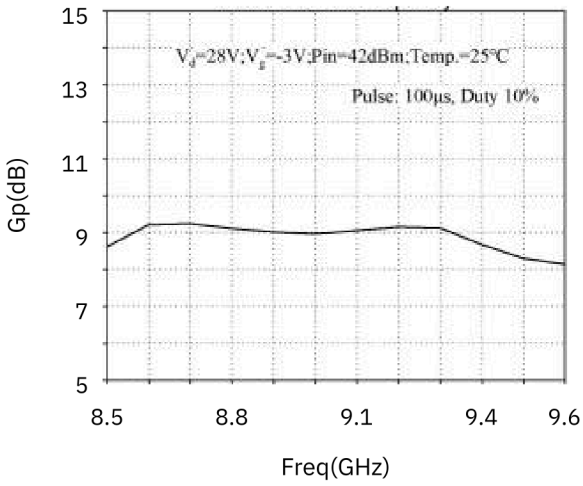
性能曲线

请结合每张图标明的工作条件阅读。









输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。 Vd = 28 V; Vg = -3 V; Pin = 42 dBm; TA = 25 °C; PW = 100 μs; D = 10%.

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。